

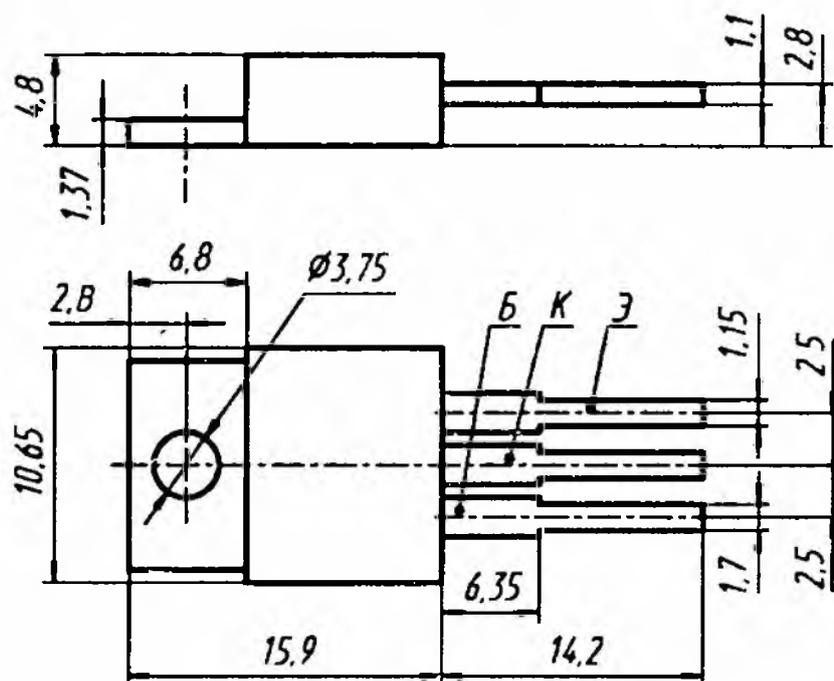
КТ835А, КТ835Б

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — АОТ Воронежский завод полупроводниковых приборов, г. Воронеж.

КТ835(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $U_{кэ} = 1$ В, $I_k = 1$ А для КТ835А,
не менее 25

при $U_{кэ} = 5$ В, $I_k = 2$ А для КТ835Б 10...100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ, не менее 1 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:

при $I_k = 1$ А, $I_b = 0,2$ А для КТ835А 0,35 В

при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А для КТ835Б 2,5 В

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб \text{ макс}}$:

КТ835А 100 мкА

КТ835Б 150 мкА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{кб} = 30$ В, не более 800 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ835А	30 В
КТ835Б	45 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	30 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....	4 В
Постоянный ток коллектора:	
КТ835А	3 А
КТ835Б	7,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T_K = -40...+25$ °С	25 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+125 °С
Температура окружающей среды	-40... $T_K =$ = +100 °С